技術ノート(近接場光関連の新しい技術)

## 磁気光学効果測定のための近接場光学系

東京農工大学工学部 佐 藤 勝 昭

最近,半導体工学で培われたナノテク ノロジーが磁性の分野にも波及し,超薄 膜や人工格子構造を用いた巨大磁気抵抗 (GMR)素子<sup>1)</sup>,磁性トンネル接合を用い たトンネル磁気抵抗(TMR)素子<sup>2)</sup>,磁性 ドットやグラニュラー構造におけるスピ ンブロッケードなど,磁性体微細構造に 基づく現象がスピンエレクトロニクスの 基礎として熱い視線を集めている.また, 磁気記録の世界においてもその高密度化 の流れはとどまるところを知らず,記録 磁区の大きさは 100 nm を切っている.

これに伴い微小領域における磁性体の 磁化状態を観測する技術の開発が求めら れている.これには大きく分けて(1) 磁性体から漏れ出す磁束を観測する手 法,例えば磁気力顕微鏡(MFM),ローレ ンツ電子顕微鏡,電子線ホログラフィー, 走査型ホールプローブ顕微鏡などと, (2)磁化そのものに基づく現象を観測す る手法,例えば磁気光学顕微鏡,スピン 偏極電子顕微鏡,X線磁気円二色性 (XMCD)顕微鏡などがある.本稿では, このうち磁気光学効果を用いて微小領域 の磁性を観測する方法についてのわれわ れの取り組み<sup>3</sup>を紹介する.

通常の光学顕微鏡の分解能 d は回折 限界で決定され、 $d=0.6\lambda/NA$ で与えら れる.ここに $\lambda$ は波長、NA レンズの開口 数<sup>(用題)</sup>である.通常の対物レンズでは NA ~0.6 であるから、分解能は波長と同程 度である.

エバネッセント光を用いて回折限界を 超える分解能を実現するのが SNOM\* で ある. 金属の遮光板に作られた狭い開口 部から漏れ出すエバネッセント光を用い て顕微鏡を作るアイデアは 1928 年に英 国の Synge によって提案されたが<sup>40</sup>, 実 験的な検証は当時の技術水準では不可能 であった. 1984 年になってようやく Pohl らが実用的な SNOM を提案し<sup>50</sup>, 1985 年 に最初のイメージングに成功した. その 後, さまざまな改良が加えられて空間分

\* SNOM: scanning near field optical microscope の頭文字をとったもの. 和訳 は走査型近接場顕微鏡.

解能が向上し,実用レベルの SNOM が実 現した. 微小な磁気構造の磁気光学 SNOM による観察は,1992 年に Betzig ら により初めて行われた<sup>6)</sup>. その後, プロー ブの改良, 制御方法, 解析法, アーティ ファクトなどに関する研究が多く報告さ れるようになった.

図1にわれわれの試作した透過モード の MO(磁気光学)-SNOM のプロック図を 示す.基本となっているのはカンチレバー 方式の AFM を用いたセイコーインスツル メンツの SPI 3700 型 SNOM である.

最も重要な部品であるプローブについ て説明しておく. 光ファイバーには single mode ファイバー (コア径 3.2 μm, クラッド径 125 µm) を用いており,図1 の挿図に示すように曲げて、先端部をと がらせプローブとしている.本研究で用 いたプローブの先端部は,熱引き法と エッチング法を組み合わせて作製され た. プローブの開口部付近は,金属(AI) が真空蒸着で被覆されている. 金属の被 覆によりクラッド層からの漏れ光を防 ぎ、伝搬光が散乱されることを防いでい る. AI 被覆の厚みは 100~150 nm, 先端 部の開口の直径は80~100 nm である. AI は酸化しやすいのでプローブの保存 には注意が必要である、 プローブはプ ローブホルダーに固定される. ホルダー にはバイモルフ(振動子)があり、プロー ブをその固有周波数(約15kHz)で振動 させるために用いる. プローブのわん曲

部が鉛直方向を向くよう取り付けるが, この装着には若干の習熟を要する.

SNOM において高い分解能を得るため には、プローブと試料との距離(浮上量) をエバネッセント場の範囲内に制御する ことが緊要である.一般的な SNOM では プローブを音さなどで振動させ、せん断 力 (shear force) を検出して制御する方 法が採られるが,本装置ではプローブが 試料に接近して原子間力が強まることに よって生じた振動の変化を, 圧電アク チュエーターにフィードバックすること によって位置制御を行う、プローブと試 料との間の原子間力による変位を検出す るために,光てこを用いる、プローブの 直線部の背の部分には反射ミラーが作ら れており、半導体レーザーを照射し、反 射光を分割型ディテクターで検出する. これにより原子間力によるプローブのた わみによる反射角の変化を感度よくとら えることができる. この方法により浮上 量は20~30 nm に制御された.

光源は、アルゴンイオンレーザーの 488 nm である. レーザー光は偏光光学系 を通し、カップラーでファイバーに結合 する. プローブから出たエバネッセント 光は試料表面で散乱を受け伝搬する光に 変換され試料を透過する.光は集光レン ズで集光される. レンズは試料ステージ を兼ねており、試料面上の走査は圧電ア クチュエーターによって試料台を動かす ことによって行われている. このことに より, AFM トポグラフ像と SNOM 光学 像が同時に得られる.透過光は偏光無依 存のダイクロイックミラーで反射され. フィルター(光てこ用半導体レーザー波 長除去)と検光子を通して光電子増倍管 に導かれる

磁気光学効果を用いたイメージング は、原理的にはプローブに直線偏光を入



図1 MO-SNOM の構成図.

射し試料の磁気光学効果による偏光の回 転を検光子により検出すれば可能であ る.しかし単なる SNOM 光学像に比べ磁 気光学像はコントラストが大変低い。十 分な光の透過強度を保った場合、ファラ デー回転はせいぜい 1~2°と小さいため である。もう一つの原因は光ファイバー プローブの偏光特性にある.ファイバー をわん曲させたことおよび先端部を絞っ たことにより、入射偏光はリターデー ションを受けだ円偏光になる.後に述べ るようにリターデーションは適当な波長 板の組み合わせで補償できるが、単純な 偏光子・検光子法を用いる限り信号対雑 音比を高くとれないので、われわれは図 1に示したように光弾性変調器 (PEM)を 用いて偏光を変調して高感度化を図っ た. 鉛直から45°の方位の直線偏光を PEM に入射すると, 光の電界の鉛直成分 と水平成分との間に pHz で変調された リターデーションを与える. 変調振幅を 4分の1波長に設定すれば左右円偏光が 交互に現れる. この変調光を光ファイ バー・プローブを通して磁性体試料に照 射し,透過光の鉛直成分を検光子で選択 すると、プローブが何らの光学異方性を もたなければ、変調周波数 (p: p=50 kHz) 成分 /(p) がファラデーだ円率<sup>(用語)</sup> を,その2倍の周波数(2p)の成分1(2p) がファラデー回転角<sup>(用語)</sup>を与える<sup>7)</sup>.

この SNOM 装置を用いて, Pt/Co MO ディスクに光磁気記録された記録マーク を観察した<sup>8)</sup>.このマークは磁界変調法 で光磁気記録されているので,記録マー クは矢羽形状となることがわかってい る. MO ディスクにはグループ(溝)が刻 まれているが,グループのある部分とグ ループのない平坦な部分のどちらにも光 磁気記録されているディスクを用いた.

図2は、この記録マークを MO-SNOM でイメージングしたものである。左の図 は AFM トポグラフ像で、凹凸のあるグ ループ像のみが見られるが、これに対し 右の図に示すように平坦部の MO 像に は、明確に矢羽形状 (マーク長 6 µm) が 観測されており、空間分解能~100 nm で



図2 Pt/Co ディスクのトポグラフ像と記 録パターンの MO-SNOM 像.

磁気光学イメージを得ることができた. グループのある部分では、白黒が反転し た線が現れているが凹凸のある試料に よって生じるアーティファクト<sup>9)</sup>である と考えられる.

ベントタイプ光ファイバープローブの ストークスパラメーターを測定した<sup>10</sup>. この結果、このプローブは波長板と同じ 偏光伝搬特性を示すことがわかった.ベ ントタイププローブでは折り曲げによる 光弾性のために位相差が生じるほか、ク ラッドを伝搬するモードが発生して、開 口からの出射光の偏光度が低下すると考 えられる.しかし、よくできたプローブ の偏光度は遠視野測定で約0.93という かなり高い値が得られており、開口から 放出される光は大部分がプローブのコア を伝搬する光であると考えられる.

このように使用したベントタイププ ローブは高い偏光度をもち, 偏光伝搬特 性は波長板と同様の振る舞いをすること がわかった.したがって,適当な位相補 償子を用いることによって補償できる. 補償前には、だ円率 ŋFと回転角 θFが混 じった信号が現れるが,補償子を用いる ことにより、回転角によるイメージ、だ 円率によるイメージを分離して得ること ができた.図3にはマーク長0.2 µmの 矢羽型記録マークのだ円率像によるイメー ジを示す. ほぼ 100 nm の解像度で磁区像 が得られた、感度は約1mrad であった。 ただ,試作された 30本のプローブのうち このような明確な特性を示すのは数本の みであるというのが現状であるという点 はご理解いただきたい. また,凹凸のあ る試料ではプローブ顕微鏡特有のアーチ ファクトがあり、ゴーストが見られるの が通常である.したがって、よい磁気光 学像を得るには表面の平坦な試料が望ま LU.

筆者らは反射型の SNOM の開発も 行っている.通常の光学像については 150 nm の分解能で得られているが,磁気 光学像については,まだ高いコントラス トを得ることができていない.今後の課 題である.

> この研究は文部省科学研究費 基盤研究(A)の助成を受けた. また,装置やプローブの開発に はセイコーインスツルメンツ社 の中島邦雄,光岡靖幸両氏にお 世話になった.また,Pt/Coディ スクは日立マクセル(株)の粟野 博之氏および(株)日立製作所の 牛山純子氏から提供を受けた. ここに感謝する.



- 図3 Pt/Coディスクに記録されたマーク 長0.2 µmの光磁気記録パターンの MO-SNOM 像.
- 1) 猪俣浩一郎: 応用物理 63, 1198 (1994).
- 2) 猪俣浩一郎: 応用物理 69, 186 (2000).
- 3) 佐藤勝昭: 固体物理 34, 681 (1999).
- 4) E. H. Synge: Phil. Mag. 6, 356 (1928).
- D. W. Pohl, W. Denk and M. Lanz: Appl. Phys. Lett. 44, 651 (1984).
- E. Betzig, J. K. Trautman, T. D. Harris, J. S. Weiner and R. L. Kostelak: Science 251, 1468 (1991).
- K. Sato: Jpn. J. Appl. Phys. 20, 2403 (1981).
- K. Sato, T. Ishibashi, T. Yoshida, J. Yamamoto, A. Iijima, Y. Mitsuoka and K. Nakajima : J. Magn. Soc. Jpn. 23, Suppl. S1, 201 (1999).
- H. Hatano, Y. Inouye and S. Kawata : Jpn. J. Appl. Phys. 37, L1008 (1998).
- T. Ishibashi, T. Yoshida, A. Iijima, K. Sato, Y. Mitsuoka and K. Nakajima : J. Microscopy **194**, 374 (1999).

-	
	用語の解説
	開口数, NA (numerical aperture): 屈
	折率を n, レンズの開口角の 1/2 を α
	として,開口数は NA=nsina で与え
	られる.
	ファラデーだ円率,ファラデー回転角:
	磁性体の磁化方向に平行に直線偏光
	を入射したとき,出射光は一般にだ円
	偏光になるが,だ円の短軸と長軸の比
	をファラデーだ円率, 主軸の回転角を
1000	
	ノアファー回転角という、

## 分類番号 7.10, 5.7

Near-field optical systems for magnetooptical measurements.

Katsuaki SATO. Faculty of Technology, Tokyo University of Agriculture and Technology. E-mail:satokats@cc.tuat. ac.jp